

11	課題番号	研究課題名	研究代表者	評価結果
	16106001	加工シリコン基盤上への窒化物半導体の選択再成長法によるナノヘテロ構造の創製	澤木 宣彦 (名古屋大学・大学院工学研究科・教授 (研究科長・学部長))	A
<p>(意見等)</p> <p>加工シリコン(Si)基板への GaN 微細単結晶の選択成長、それを用いる新規光・電子デバイスによる高温での量子効果発現を目指す研究である。</p> <p>これまでに、Si のファセット面を用いるヘテロ構造形成機構やドーピング機構に関する知見を集積し、学術的成果を挙げつつある。また、技術面においても、次世代の光電子融合デバイスの分野開拓の芽となる可能性を秘めている。</p> <p>今後は、緩衝層の役割の体系的理解や転位低減のための歪制御などを鋭意進め、当初の目標を達成することを期待する。</p>				
12	課題番号	研究課題名	研究代表者	評価結果
	16106002	低次元微小構造体の界面破壊	北村 隆行 (京都大学・大学院工学研究科・教授)	A
<p>(意見等)</p> <p>研究は目的、計画に沿って概ね順調に行われており成果も得られつつある。成果に関しては特にナノスケールでの界面破壊を実現実験できる装置開発が高く評価できる。反面、本課題に直接結びついた学術論文が未だ発表されておらず今後の努力が望まれる。理論、解析の面では、離散系と連続系の適切な融合、実験と対比手法の確立が重要であり、ナノスケールでの界面破壊のクライテリアが得られるかどうか、対象が難解であるだけに格段の努力が期待される。</p> <p>研究経費に関し、特定領域研究と重複しており、共に高額の研究費であって単独の成果が求められるので、引き続き使途と成果の住み分けと峻別が必要である。</p>				